

3.4. Fototranzystory / $t_{amb} = -40 \dots +55^{\circ}C$, $t_{stg} = -40 \dots +70^{\circ}C$ /

Oznaczenie wyrobu	Parametry dopuszczalne				Parametry charakterystyczne							Zastosowanie	Obudowa
	U_{CE}	U_{EC}	P_{tot}	I_0 przy U_{CE}	$T_b = 2856 K; E = 1000 lx$		t_r	t_f	f_T				
	V	V	mW	μA	I_L przy U_{CE}	V	μs	μs	kHz				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BPRP 22 ^{1/}	≤ 30	≤ 5	≤ 100	$\leq 0,1$	15	$\geq 0,7$	5	≤ 5	≤ 5	≥ 70	c	CO 28	
BPRP 24	≤ 15	≤ 5	≤ 100	$\leq 0,1$	15	$\geq 0,8$	5	≤ 10	≤ 10	≥ 60	a	CO 26	
BPRP 25	≤ 15	≤ 5	≤ 20	$\leq 0,1$	15	$\geq 0,1$	5	≤ 10	≤ 10	≥ 60	a	CO 30	
BXP 28	≤ 25	≤ 5	≤ 150	$\leq 0,2$	5	A: $\geq 0,5^2$ B: $\geq 10^2$	2	≤ 900	≤ 1000		b	CO 09	
BFYP 21 ^{3/}	≤ 8	≤ 5	≤ 50	$\leq 0,5$	6	$\geq 0,05$	5	≤ 10	≤ 10	≥ 30	a	CO 03	
BFYP 22	≤ 15	≤ 5	≤ 100	$\leq 0,1$	15	$\geq 0,25$	12	≤ 10	≤ 10	≥ 60	a	CO 04	
BFYP 24	≤ 15	≤ 5	≤ 100	$\leq 0,1$	15	$\geq 1,0$	5	≤ 10	≤ 10	≥ 60	a	CO 08	
BFYP 25	≤ 15	≤ 5	≤ 20	$\leq 0,1$	15	$\geq 0,1$	5	≤ 10	≤ 10	≥ 60	a	CO 36	
BFYP 26 ^{4/}	≤ 15	≤ 5	≤ 20	$\leq 5,0$	15	$\geq 0,2$	5	≤ 10	≤ 10	≥ 60	a	CO 39	

1/ fototranzystor z wyprowadzoną bazą

2/ przy $E = 100 lx$

3/ $t_{stg} = -40 + +100^{\circ}C$

4/ pole odczytowe składające się z dziewięciu fototranzystorów

- a optoelektroniczne łącza foniczne, układy zdalnego sterowania, przetworniki analogowo-cyfrowe, czynniki taśm perforowanych
 - b układy zdalnego sterowania i detekcji promieniowania widzialnego i podczerwonego o małym natężeniu, przetworniki analogowo-cyfrowe, optoelektroniczne łącza foniczne
 - c układy automatyki i sterowania, przetworniki analogowo-cyfrowe, może być stosowany jako fotodetektor w fototransoptorach
- Polaryzacja wszystkich fototranzystorów n-p-n